

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

ОТЧЕТ

По лабораторной работе №2

Название: <u>Три с</u> Дисциплина: <u>Эл</u>	схемы включен <u>тектроника</u>	ия транзист	<u>ropa</u>	
Студент	ИУ-42б			С.В.Астахов
Преподаватель	(Группа)		(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)
			(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)

Цель: изучить, как влияют различные способы включения биполярного транзистора и величина сопротивления нагрузки на свойства усилительного каскада.

Исходные данные:

E	k	В	I s	R1	R ₂	Rk, Rə	Re	Сбэ	Сбк	f	C1, C2	Сблок	Rн
ι	/		Α	кОм	кОм	кОм	кОм	пΦ	пΦ	MHz	мкФ	мкФ	кОм
9)	140	Ge	15	8	2	3	10	25	40	5	200	5

Схема с общим эмиттером

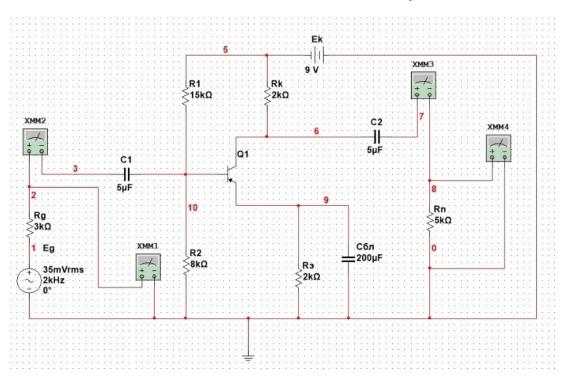


Схема с общим эммитером

Определим параметры Spice – модели транзистора по исходным данным из таблицы выше:

.model PNP TRANSISTORS VIRTUAL 1 1 PNP				Tools +	Views	
N Description	Value	U	Use de			
L Device model level	Gummel-P					
IS Transport saturation current	1e-009	Α				
BF Ideal maximum forward beta	140					
NF Forward current emission coefficient	1.0		☑			
V Forward Early voltage	1e30	V	☑			
IKF Corner for forward beta high current roll-off	1e30	Α	☑			
ISE B-E leakage saturation current	0	Α	☑			
NE B-E leakage emission coefficient	1.5		☑			
BR Ideal maximum reverse beta	1		☑			
NR Reverse current emission coefficient	1		✓			
V Reverse Early voltage	1e30	V	☑			
IKR Corner for reverse beta high current roll-off	1e30	Α	☑			
ISC B-C leakage saturation current	0	Α	✓			
NC B-C leakage emission coefficient	2		☑			
RB Zero-bias base resistance	0	Ω	☑			
IRB Current where base resistance falls halfway to its minimum value	1e30	A	☑			
R Minimum base resistance at high currents	0	Ω	☑			
RE Emitter resistance	0	Ω	Ø			
RC Collector resistance	0	Ω	☑			
CJE B-E zero-bias depletion capacitance	1e-011	F				
VJE B-E built in potential	0.466666	V				
M B-E junction exponential factor	0.33		☑			

Произведем расчет входного и выходного напряжения, а так же входного и выходного тока для различных случаев нагрузочного сопротивления.

По полученным данным произведем расчет коэффициентов передачи по току, напряжению и мощности, а так же входное и выходное сопротивление.

Формулы:

Коэффициент передачи усилителя по току: $K_i = I_{\text{вых}} / I_{\text{вх}}$

Коэффициент передачи усилителя по напряжению: $K_{\rm u}$ = $U_{\scriptscriptstyle \rm Bblx}$ / $U_{\scriptscriptstyle \rm BX}$

Коэффициент передачи усилителя по мощности: $K_{\rm p}$ = $K_{\rm i}$ * $K_{\rm u}$

Результаты:

esymbrara.							
Rн	Івх, МКА	Івых, МКА	Uвх, мВ	Uвых, В	Kı	Κυ	KP
0,2 кОм	7,1	588,3	13,5	0,1	82,8	7,4	612,7
1 кОм	7,1	431,5	13,5	0,43	60,7	31,8	1930,26
5 кОм	7,1	184,9	13,5	0,92	26	68,1	1770,6
250 кОм	7,1	5,1	13,5	2,3	0,7	170,3	119,2

Входное сопротивление: $R_{BX} = U_{BX} / I_{BX} = 13.5 * 10^{-3} / 7.1 * 10^{-6} = 1.9 кОм$

Для расчета выходного сопротивления запустим схему в режиме холостого хода и короткого замыкания.

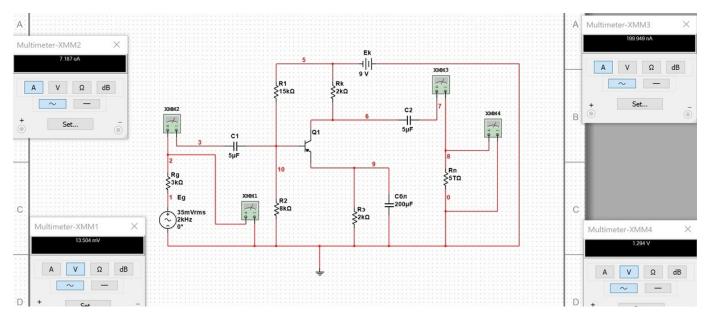


Схема в режиме XX

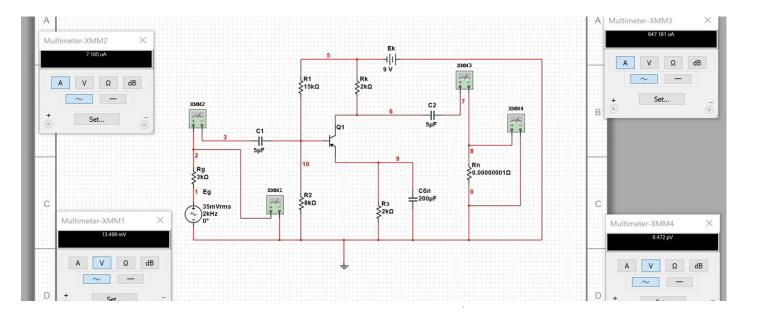


Схема в режиме КЗ

Выходное сопротивление: $R_{\text{вых}} = U_{xx} / I_{\kappa 3} = 1,87 \ \kappa \text{Ом}$

Произведем аналитический расчет параметров, полученных с помощью эксперимента и сравним полученные результаты.

Коэффициенты передачи определим с помощью следующих формул:

Входное сопротивление: $R_{\text{вх}} = R_{\text{вх тр оэ}} * R_6 / R_{\text{вх тр оэ}} + R_6$

Сопротивление базы: $R_6 = R_1 * R_2 / R_1 + R_2$

Входное сопротивление транзистора: $R_{\text{вх тр оэ}} = r_6 + (1+B)^* r_{\text{эм}}$, где $r_6 = 0$ Ом, $r_{\text{эм}} = \varphi / I$; $\varphi = 0,026$ В

Коэффициент передачи усилителя по току: K_i = (R_6 / (R_6 + $R_{\text{вх тр оэ}}$)) * B * R_{κ} / (R_{κ} + $R_{\text{н}}$) Коэффициент передачи усилителя по напряжению: K_u = B * $R_{\kappa \text{н}}$ / $R_{\text{вх тр оэ}}$; $R_{\kappa \text{н}}$ = R_{κ} * $R_{\text{н}}$ / R_{κ} + $R_{\text{н}}$ / $R_{\text{н}}$

Коэффициент передачи усилителя по мощности: $K_p = K_i * K_u$

Выполним расчет и результаты занесем в таблицу.

Ток эмиттера рассчитаем с помощью схемы, приведенной ниже.

Получаем, что I_{3M} = 1,359 * 10⁻³ A

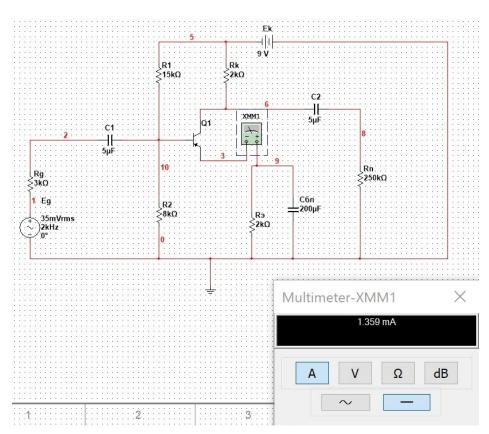
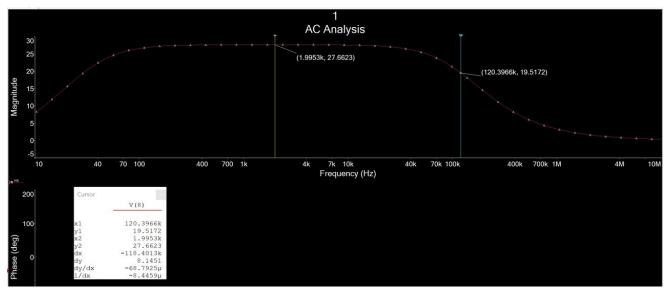


Схема для рассчета тока эмиттера

R _н	Rвx	Rвых	Kı	Κυ	KР
0,2 кОм			83,89	9,4	788,5
1 кОм	1,76 кОм	1,87 кОм	61,52	34,2	2103,9
5 кОм			26,36	74,1	1953,2
250 кОм			0,7	169,9	118,93

В результате произведенных вычислений аналитическим способом и данных полученных экспериментальным путем получились схожие данные.

Определим граничную частоту работы транзистора с общим эмиттером. Для этого построим АЧХ тока.



АЧХ тока

Граничная частота находится на отметке при напряжении в √2 раз меньше максимального. Исходя из рисунка получаем, что f_B = 120,3 кГц. Для определения постоянной времени цепи, найдем коэффициент G по формуле:

$$G = (R'_r + r_6 + r_9) / (R'_r + R_{Bx \tau p o 9}) = 0,41;$$

Где
$$R_r = R_r * R_6 / (R_r + R_6) = 1,9 кОм$$

Постоянную времени цепи найдем по формуле:

$$au_{\text{B}}$$
= G * (au_{B} + С $_{\text{кэ}}$ * R $_{\text{кн}}$) + С $_{\text{H}}$ * R $_{\text{кн}}$, где С $_{\text{H}}$ = 0 Ф

$$\tau_{\rm B}$$
 = (B + 1)/ $2\pi f_{\rm a}$ = 5,6 * 10⁻⁷

$$C_{\kappa 9} = C_{6\kappa}(B+1) = 3.525* 10^{-9}$$

$$\tau_{\rm B}$$
 = 2,2 MKC

Схема с общей базой

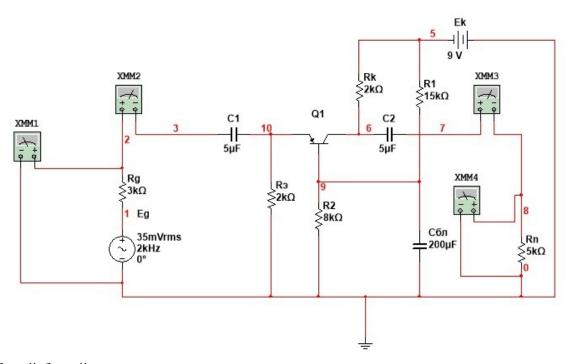


Схема с общей базой

Произведем расчет входного и выходного напряжения, а так же входного и выходного тока для различных случаев нагрузочного сопротивления.

По формулам из пункта 1 рассчитаем коэффициенты передачи по току, напряжению и мощности.

Rн	Івх, А	Івых, А	U _{вх,} В	Uвых, В	Kı	Κυ	KP
0,2 кОм		10,3e-6		2e-3	0,89	7	6,23
1 кОм	11,5e-6	7,6e-6	2,8e-4	7,6e-3	0,66	27,14	17,9
5 кОм		3,2e-6		16,2e-3	0,27	57,8	15,6
250 кОм		0,8e-7		22,6e-3	0,06	80,7	4,8

Входное сопротивление: $R_{Bx} = U_{Bx} / I_{Bx} = 2.8 * 10^{-4} / 11.5 * 10^{-6} = 24 \text{ Om}$

Для расчета выходного сопротивления запустим схему в режиме холостого хода и короткого замыкания аналогчино пункту 1.

Выходное сопротивление: $R_{\scriptscriptstyle BblX} = U_{\scriptscriptstyle XX} / I_{\scriptscriptstyle K3} = 24$ Ом

Произведем аналитический расчет параметров, полученных с помощью эксперимента, и сравним полученные результаты.

Коэффициенты передачи определим с помощью следующих формул:

Входное сопротивление: $R_{BX} = (R_{BX TP O6} * R_9 / (B+1)) / (R_{BX TP O6} + R_9 / (B+1))$

Сопротивление базы: $R_6 = R_1 * R_2 / R_1 + R_2$

Входное сопротивление транзистора: $R_{\text{вх тр об}} = r_6 + (1+B)^* r_{\text{эм}}$, где $r_6 = 0$ Ом, $r_{\text{эм}} = \varphi / I$; $\varphi = 0,026$ В

Коэффициент передачи усилителя по току: $K_i = R_9 * a * R_\kappa / ((R_9 + R_{вх тр об} / (B+1)) / (R_\kappa + R_\mu)), a = B/(B+1)$

Коэффициент передачи усилителя по напряжению: $K_u = B * R_{\kappa H} / R_{BX TD O9}$; $R_{\kappa H} = R_{\kappa} * R_{H} / R_{\kappa} + R_{H}$

Коэффициент передачи усилителя по мощности: $K_p = K_i * K_u$

Выполним расчет и результаты занесем в таблицу.

Ток эмиттера рассчитаем с помощью схемы, приведенной ниже. Получаем, что $I_{\tiny эм}$ = 1,358 * 10⁻³ A

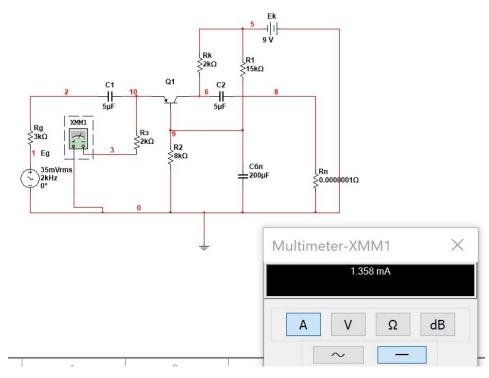


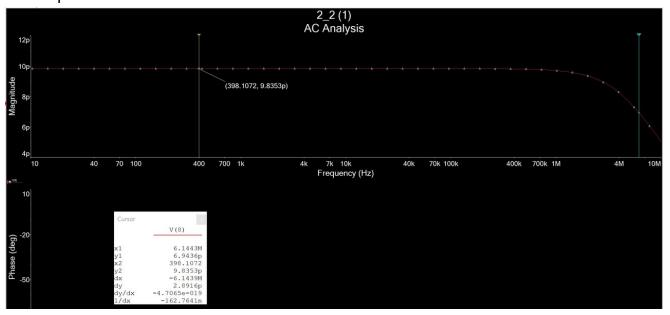
Схема для рассчета тока эммитера

Результаты расчетов

R _н	Rвx	Rвых	Kı	Κυ	KР
0,2 кОм	8,2 мОм	24 Ом	0,89	9	8
1 кОм			0,65	28,2	18,3
3 кОм			0,28	58,8	16,4
250 кОм			0,07	81,8	5,7

Значения полученные аналитическим путем получились близкими к значениям полученным экспериментально, следовательно, расчеты выполнены верно.

Определим граничную частоту работы транзистора с общим эмиттером. Для этого построим АЧХ тока.



АЧХ тока

Для определения постоянной времени цепи, найдем коэффициент G по формуле:

$$G = (R'_r + r_6 + r_9) / (R'_r * (B+1) + R_{BXTPO6}) = 0,007;$$

Где
$$R_r = R_r * R_6 / (R_r + R_6) = 1.9 кОм$$

Постоянную времени цепи найдем по формуле:

$$\tau_{B}$$
= G * (τ_{B} + $C_{\kappa 9}$ * $R_{\kappa H}$) + C_{H} * $R_{\kappa H}$, где C_{H} = 0 Ф

$$\tau_{\rm B}$$
 = (B + 1)/ $2\pi f_{\rm a}$ = 5,6 * 10⁻⁷

$$C_{\kappa 9} = C_{6\kappa}(B+1) = 3.525* 10^{-9}$$

$$\tau_{\rm B}$$
 = 3,9 MKC

Схема с общим коллектором

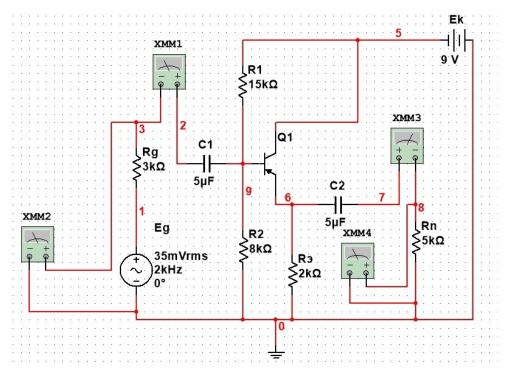


Схема с общим коллектором

Произведем расчет входного и выходного напряжения, а так же входного и выходного тока для различных случаев нагрузочного сопротивления.

По формулам из пункта 1 рассчитаем коэффициенты передачи по току, напряжению и мощности. Результаты приведены в таблице

<i>Rвх кОм</i>	<i>Rн кОм</i>	Івх, МКА	Івых, МКА	Uвх, мВ	Uвых, мВ	Kı	Κ υ	KP
4,4	0,2	4,7	93,9	20,8	18,7	19,9	0,89	17,7
4,9	1	4,4	21,1	21,7	21,1	4,7	0,97	4,5
5,1	5	4,3	4,3	22	21,7	1	0,98	0,98
5,1	250	4,3	0,087	22	21,8	0,02	0,99	0,0198

Для расчета выходного сопротивления запустим схему в режиме холостого хода и короткого замыкания

Произведем аналитический расчет параметров, полученных с помощью эксперимента, и сравним полученные результаты.

Выходное сопротивление: $R_{вых} = U_{xx} / I_{к3} = 2,28 \text{ кОм}$

Коэффициенты передачи определим с помощью следующих формул:

Входное сопротивление: $R_{BX} = R_6 * (R_{BXTp} + R_{3H} * (B+1)) / ((R_{BXTp} + R_{3H} * (B+1)) + R_6)$

Сопротивление базы: $R_6 = R_1 * R_2 / R_1 + R_2$

Входное сопротивление транзистора: $R_{\text{вх тр ок}} = r_6 + (1+B)^* r_{\text{эм}}$, где $r_6 = 0$ Ом, $r_{\text{эм}} = \varphi / I$; $\varphi = 0,026$ В

Коэффициент передачи усилителя по току: $K_i = R_9 * (B+1) * R_6 / (((R_6 + R_{вх тр} + (B+1)*R_9) * (R_9 + R_H)),$

Коэффициент передачи усилителя по напряжению: $K_u = (B+1) * R_{\text{эн}} / (((R_6 + R_{\text{вх тр ок}} + (B+1) * R_{\text{э}}); R_{\text{эн}} = R_{\text{э}} * R_{\text{н}} / R_{\text{э}} + R_{\text{н}}$

Коэффициент передачи усилителя по мощности: $K_p = K_i * K_u$

Выходное сопротивление: $R_{\text{вых}} = R_{\text{\tiny 3}} * ((r_{\text{\tiny 3}} + (R'_{\text{\tiny F}} + r_{\text{\tiny 6}})/(B+1)) / (R_{\text{\tiny 3}} + ((r_{\text{\tiny 3}} + (R'_{\text{\tiny F}} + r_{\text{\tiny 6}})/(B+1)))$

Выполним расчет и результаты занесем в таблицу.

Ток эмиттера рассчитаем с помощью схемы, приведенной ниже. Получаем, что $I_{\scriptscriptstyle \mathsf{ЭM}}$ = 1.359 mA

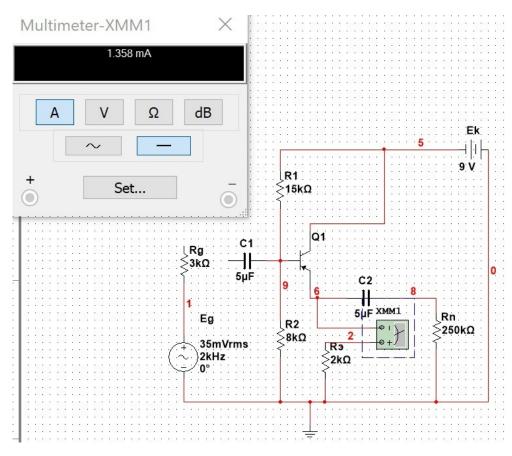


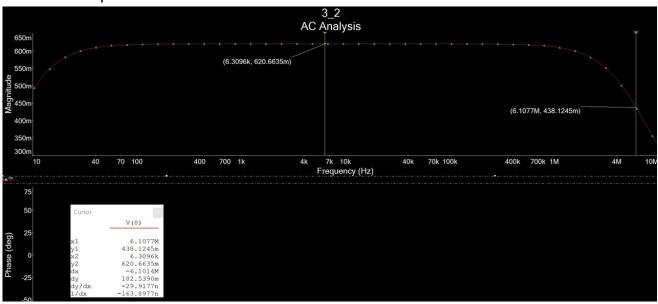
Схема для рассчета тока эмиттера

Результаты расчетов

<i>R</i> н,Ом	<i>Rэн , Ом</i>	<i>Rвх , Ом</i>	Kı	Κ υ	KP
200	181,8	4409	18,5	0,9	16,6
1000	666,6	4950,6	5,1	0,95	4,8
5000	1428,5	5087,4	0,7	1	0,7
250000	1984,1	5122,8	0,02	1,02	0,02

Значения полученные аналитическим путем получились близкими к значениям полученным экспериментально, следовательно, расчеты выполнены верно.

Определим граничную частоту работы транзистора с общим эмиттером. Для этого построим АЧХ тока.



АЧХ тока

Граничная частота находится на отметке при напряжении в $\sqrt{2}$ раз меньше максимального. Исходя из графика, получаем, что f = 6 МГц

Для определения постоянной времени цепи, найдем коэффициент G по формуле:

$$G = (R'_r + r_6 + r_9 + R_{9H}) / (R'_r + R_{9H}^* (B+1) + R_{BX TP O6}) = 0.016;$$

Где
$$R_r = R_r R_6 / (R_r + R_6) = 1.9 кОм$$

Постоянную времени цепи найдем по формуле:

$$au_{B}$$
= G * (au_{B} + С_{кэ}* R_{кн}) + С_н * R_{кн}, где С_н = 0 Ф

$$\tau_{\rm B}$$
 = (B + 1)/ $2\pi f_{\rm a}$ = 5,6 * 10^{-7}

$$C_{\kappa 9} = C_{6\kappa}(B+1) = 3,525* 10^{-9}$$

$$\tau_{\rm B}$$
 = 0,08 MKC

Вывод: в ходе данной лабораторной работы было изучено влияние способа включения биполярного транзистора и величины сопротивления нагрузки на свойства усилительного каскада.